








	<p><b>APT1001RBN</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">APT1001RBN</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1KV 11A TO247AD</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">APT1001RBN.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12388 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">APT1001RBN</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1KV 11A TO247AD
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12388 pcs Stock
Serie	POWER MOS IV®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AD
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2950pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube



















































APT1001RBN ist neu im Original, Suche APT1001RBN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie APT1001RBN Microsemi mit Garantie und Vertrauen. Anfrage APT1001RBN: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>APT06DC60HJ</b> Microsemi DIODE SIC SCHOTTKY 600V SOT227</p>	 <p><b>APT1001RBNR</b> IXYS APT1001RBNR IXYS</p>	 <p><b>APT1001R1BN</b> Microsemi MOSFET N-CH 1KV 10.5A TO247AD</p>	 <p><b>APT1001RBVR</b> APT APT1001RBVR APT</p>
 <p><b>APT000-1900-007</b> APT IGBT Modules</p>	 <p><b>APT1001RBVFRG</b> APT APT1001RBVFRG APT</p>	 <p><b>APT000-1900-008</b> APT IGBT Modules</p>	 <p><b>APT1001RBVRG</b> Microse APT1001RBVRG Microse</p>

### heiße Teile

Mehr

 APT 1147	 APT000-1900-002	 APT000-1900-005	 APT000-1900-007	 APT000-1900-008
 APT1001R1BN	 APT1001R3BN	 APT1001RBNR	 APT1001RBVFR	 APT1001RBVRG
 APT10021JFLL	 APT10021JLL	 APT10025JLC	 APT10025JLCX	 APT10025JN
 APT10025JVFR	 APT10025JVR	 APT10025PVR	 APT10026JFLL	 APT10026JLL
 APT10026JN	 APT10026JNR	 APT10026JNRX	 APT10026JVFR	 APT10026JVR
 APT10026L2FLLG	 APT1002R4BN	 APT10030L2VR	 APT10035B2FLL	 APT10035JFLL
 APT10035JLL	 APT10035JLLX	 APT10035LFLG	 APT1003RBLL	 APT1003RBLLG
 APT1003RKFLG	 APT1003RSFLL	 APT10040LVR	 APT10043JVR	 APT10045JFLL
 APT10045JLL	 APT10045LFLG	 APT10045LLL	 APT1004RBNG	 APT1004RGN
 APT10050JLC	 APT10050JN	 APT10050JVFR	 APT10050JVR	 APT10050JVRF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited